



応用物理学会 薄膜・表面物理分科会、シリコンテクノロジー分科会 共催

「電子デバイス界面テクノロジー研究会

—材料・プロセス・デバイス特性の物理—(第22回)

(旧「ゲートスタック研究会」)

協賛: 日本物理学会, 日本化学会, 日本金属学会, 日本表面科学会, 電子情報通信学会, 電気学会, 触媒学会, 日本真空学会
電気化学会, 表面技術協会, 日本顕微鏡学会, 日本セラミックス協会, 精密工学会

半導体デバイスの研究開発において、構造、材料の変革が進んでいます。ロジックLSIでは、FIN構造やナノワイヤ型に代表される立体構造や新しい高移動度チャンネル材料を用いたトランジスタ開発が活発に進められています。パワーデバイスにおいては、SiCやGaNデバイスの開発が進み、新しい展開が始まっています。これら様々なデバイスで性能の鍵を握るのが界面テクノロジーです。異種材料界面の科学的な理解はデバイス研究開発に不可欠なものとなっています。本研究会は産・官・学の第一線の研究者がデバイス界面に関する様々なテーマについて基礎から応用までを理論と実験の両面から議論し、本分野の発展に貢献することを目的としています。本研究会は1996年から2015年まで20回にわたり開催されてきた「極薄シリコン酸化膜の形成・評価・信頼性研究会」、「ゲートスタック研究会—材料・プロセス・評価の物理—」の歴史を継承し、前回より一層スコープを広げ、新たな名称のもとスタートしました。国内外からの招待講演者のほかに、一般の口頭発表とポスター発表を広く募集して開催します。さらに研究会前日にはチュートリアルを開催します。奮ってご参加下さい。

- 日時: 2017年1月20日(金)~21日(土)。前日(19日)の夜に、チュートリアルを実施。
- 場所: 東レ総合研修センター; 〒411-0032 静岡県三島市末広町21-9, Tel:055-980-0333 Fax:055-980-0350
http://www.toray.co.jp/network/loc_004.html
- 招待講演者(敬称略):

<p>I 基調講演</p> <ul style="list-style-type: none"> 尾嶋 正治 (東大) 「放射光光電子分光によるデバイス界面の解析」 渡辺 行彦 (豊田中研) 「次世代自動車のためのパワーデバイス(仮)」 <p>II 招待講演</p> <ul style="list-style-type: none"> 岡 徹 (豊田合成) 「縦型 GaN パワーデバイス開発の最近の進展」 須田 淳 (京大) 「GaN のパワーデバイス応用に向けた基礎物性評価、プロセス技術」 田畑 仁 (東大) 「散逸ゆらぎを活用した新規デバイスの可能性」 	<ul style="list-style-type: none"> 東 悠介 (東芝) 「共鳴核反応法によるゲート絶縁膜中水素分布測定と水素起因信頼性劣化モデリング」 Robert Baumann (Texas Instruments) 「TIにおける宇宙関連事業(仮)」 <p>III 企画セッション</p> <p>「国内に残さねばならない半導体技術 ~宇宙, 通信, パワー~(仮)」</p> <p>廣瀬 和之 (東大/JAXA)、宮本 恭幸 (東工大)、岩室 憲幸 (筑波大)</p> <p>IV チュートリアル</p> <p>伊藤公平 (慶応大) 「300mm シリコン量子コンピュータ開発最前線: 基礎からの解説」</p>
--	---

- 参加費および宿泊費(消費税込):
 - 参加費(含資料代): 薄膜及びSiテクノロジー分科会会員 15,000円, 応用物理学会・協賛学協会員 19,000円, 一般 24,000円, 学生 8,000円
※但し薄膜及びSiテクノロジー分科会賛助会社の方は分科会会員扱い, 応用物理学会賛助会社の方は応用物理学会会員扱いとします。
 - 宿泊費: 前日(19日)宿泊費(初日朝食付): 8,000円, 初日(20日)宿泊費(2日目朝食, 初日および2日目の昼食付): 9,500円。
宿泊は個室となります。宿泊されない方が昼食(両日共)を希望される場合, 事前申し込みによりお受け可能です。
- 定員: 200名 (ただし宿泊定員は150名。満員になり次第締切ります。)
- 申込手続および締切:
 - 一般講演申込(口頭発表またはポスター発表), 締切: 2016年10月24日(月)
申込先: <http://home.hiroshima-u.ac.jp/oxide/>
上記Web siteの指示に従って, 発表題目, 発表者氏名(共著者名含む)および連絡先(住所, TEL, FAX, e-mail)を日本語・英語併記し, 発表概要を和文1000文字以内または英文500ワード以内にとまとめて, 入力して下さい。また, 口頭あるいはポスター発表のご希望には, 必ずしも添えない場合があることを予めご承知下さい。
 - 参加申込(上記Web siteにてお申込下さい。), 締切: 2016年12月12日(月) (1)参加者名 (2)性別 (3)連絡先(住所, TEL, FAX, e-mail) (4)参加費種別(会員の方は会員番号)・金額 (5)参加費振込予定日 (6)前日(1月19日)宿泊希望の有無 (7)初日(1月20日)宿泊希望の有無を明記してください。
費用は, 参加費・前日泊も含むすべての宿泊費を同時にまとめて下記口座に参加者名で1月10日までにお振り込み下さい。
参加費等の振込先: 三井住友銀行 本店営業部(本店も可) 普通預金 9474715 (社)応用物理学会 薄膜・表面物理分科会
参加費お振り込みの際は, 受付番号および氏名カナを振込名義人欄にご入力ください。 例: 5001 オウブツタロウ
所属先から複数名の方々の参加費をお振り込みの際は, 受付番号のみご入力ください。 例: 5001 5003 5007
なお, 申込後の取り消しや不参加の場合, 参加費等の払い戻しは致しません。また, 請求書の発行は致しません。
担当: 応用物理学会事務局 小田康代
- 予稿原稿締切: 2016年12月12日(月), 4頁(A4)以内(図表およびアブストラクトを含む), 本文は日本語または英語, アブストラクトと図表およびその説明は英語として下さい。上記研究会Web siteの指示に従って, pdfファイルで送信して下さい。尚, 発表申し込み時に登録した発表題目や共著者名等を変更される場合は, 必ずWeb siteの指示に従って, 再入力をお願いいたします。
- その他: 発表言語は日本語または英語, 発表用の図(OHP, ポスター)は英語
- 運営体制:
 - ◎運営委員: 野平 博司(東京都市大: 運営委員長), 浦岡 行治(奈良先端大), 金田 千穂子(富士通研), 高木 信一(東大), 立花 明知(京大), 生田目 俊秀(物材機構), 丹羽 正昭(東北大学), 宮崎 誠一(名大), 山部 紀久夫(筑波大)
 - ◎実行・プログラム委員: 武田 さくら(奈良先端大: 実行委員長), 澤野 憲太郎(東京都市大: プログラム委員長), 島本 聡(日立国際電気: 副プログラム委員長), 赤坂 泰志(東京エレクトロン), 井上 真雄(ルネサス), 岩本 邦彦(ローム), 遠藤 哲郎(東北大), 太田 裕之(産総研), 岡田 健治(パナソニック), 岡本 大(筑波大), 小川 慎吾(東レ), 押山 到(ソニー), 角嶋 邦之(東工大), 影島 博之(島根大), 上牟田 雄一(東芝), 喜多 浩之(東大), 近藤 博基(名大), 白石 賢二(名大), 杉田 義博(ソシオネクスト), 知京 豊裕(物材機構), 寺本 章伸(東北大), 中塚 理(名大), 長田 貴弘(物材機構), 中山 隆史(千葉大), 蓮沼 隆(筑波大), 久本 大(日立), 松下 大介(東芝), 三谷 祐一郎(東芝), 森 博子(ソシオネクスト), 山元 隆志(東レ), 渡邊 孝信(早大), 渡部 平司(阪大)
- 問い合わせ先: 澤野憲太郎(東京都市大) E-mail: sawano@tcu.ac.jp
- ホームページ: <http://home.hiroshima-u.ac.jp/oxide/>

*予稿集への広告掲載を募集します(5万円/A4 白黒1ページ)。詳細はお問い合わせ下さい。